

**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**  
**PUBLIC RELATIONS DIVISION**  
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan

**PARA LANÇAMENTO IMEDIATO**

**N.º 3029**

*Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.*

*Consultas de clientes*

Semiconductor & Device Marketing Div.B  
Mitsubishi Electric Corporation

[www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/](http://www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/)

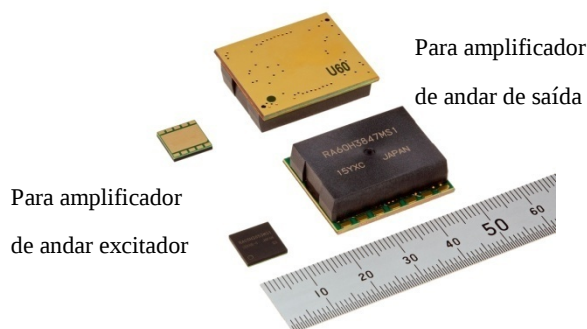
*Questões da imprensa*

Public Relations Division  
Mitsubishi Electric Corporation  
[prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp](mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp)  
[www.MitsubishiElectric.com/news](http://www.MitsubishiElectric.com/news)

**A Mitsubishi Electric vai lançar módulos RF MOSFET de alto rendimento e de silicone para equipamentos transctores profissionais**

*É o primeiro módulo MOSFET a permitir a montagem automática em placas de circuito impresso de transctores profissionais*

**TÓQUIO, 15 de junho de 2016** – A [Mitsubishi Electric Corporation](http://www.MitsubishiElectric.com) (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que vai lançar comercialmente, a 1 de julho, novos módulos de radiofrequência (RF) e alto rendimento de transístores de efeito de campo de semicondutor de óxido metálico (MOSFET), em silicone, com capacidade de montagem automática em placas de circuito impresso de equipamentos rádio profissionais. Sendo os primeiros modelos MOSFET na classe de potência de saída de 60 W com esta capacidade (segundo investigação da própria Mitsubishi, à data de 15 de junho), é de esperar que estes módulos aumentem a produtividade do fabrico de equipamentos rádio profissionais ao eliminar a necessidade de aparafusamento e de outros processos de montagem. Estarão disponíveis, enquanto par, dois tipos de módulo com circuitos de transmissores para equipamentos transctores profissionais.



Par de módulos RF MOSFET de alto rendimento e de silicone

Os amplificadores de alta potência para equipamentos rádio profissionais são habitualmente instalados nos armários através de parafusos, originando pedidos de soluções de montagem mais eficientes. Para além de responder a esta necessidade, os novos módulos MOSFET da Mitsubishi Electric vão ajudar a reduzir a dimensão e o consumo de energia dos equipamentos rádio.

### **Funcionalidades do produto**

#### **1) Primeiro módulo MOSFET de montagem automática**

- Graças a um design resistente ao calor que consegue suportar a temperatura da soldadura por refusão, os módulos podem ser instalados automaticamente, o que irá aumentar a produtividade do fabrico de equipamentos rádio

#### **2) A otimização do desenho dos circuitos reduz a dimensão, o peso e o consumo de energia (em comparação com a atual série RA)**

- A otimização do desenho térmico e dos circuitos reduz a pegada energética dos módulos para metade e o peso dos atuais dissipadores de calor para um terço
- O consumo de energia foi melhorado através de uma redução de 80% na potência de entrada necessária (atualmente de 10 mW) e de um aumento de 5% na eficiência do dreno (atualmente de 60% no total)

#### **3) Dois tipos de módulos disponíveis como par para equipamentos de transmissão rádio profissionais**

- Os módulos para andar excitador e andar de saída, disponibilizados como par, libertam os clientes da necessidade de desenhar circuitos que estejam alinhados, aumentando ainda mais a produtividade do fabrico

### **Calendário de vendas**

| Frequência de funcionamento | Modelo*      | Especificações          |                     |                   |                       | Envio      |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------|
|                             |              | Tensão de funcionamento | Potência de entrada | Potência de saída | Eficiência energética |            |
| 135-175 MHz                 | RA05H1317MS1 | 12,5 V                  | 10 mW               | 85 W              | 60%                   | 1 de julho |
|                             | RA60H1317MS1 |                         |                     |                   |                       |            |
| 378-470 MHz                 | RA05H3353MS1 |                         |                     |                   | 53%                   |            |
|                             | RA60H3847MS1 |                         |                     |                   |                       |            |
| 440-527 MHz                 | RA05H3353MS1 |                         |                     |                   | 52%                   |            |
|                             | RA60H4453MS1 |                         |                     |                   |                       |            |

\*figura acima: módulo de andar excitador; figura abaixo: módulo de andar de saída

### **Especificações**

| Tipo de módulo            | Modelo       | Frequência de funcionamento | Potência de saída | Eficiência do dreno | Potência de entrada | Tensão de funcionamento |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Módulo de andar excitador | RA05H1317MS1 | 135-175 MHz                 | 5 W               | 50-60%              | 10 mW               | 12,5 V                  |
|                           | RA05H3353MS1 | 330-527 MHz                 |                   |                     |                     |                         |
| Módulo de andar de saída  | RA60H1317MS1 | 135-175 MHz                 | 60 W              | 55-65%              | 4 W                 | 12,5 V                  |
|                           | RA60H3847MS1 | 378-470 MHz                 |                   |                     |                     |                         |
|                           | RA60H4453MS1 | 440-527 MHz                 |                   |                     |                     |                         |

### **Outras características**

**1) *O alinhamento dos circuitos reduz a carga sobre o desenho de circuitos RF***

Os circuitos com correspondência de impedância incorporada maximizam o desempenho de radiofrequência dos MOSFET de alta potência, ajudando assim a reduzir o prazo de desenvolvimento de equipamentos rádio profissionais

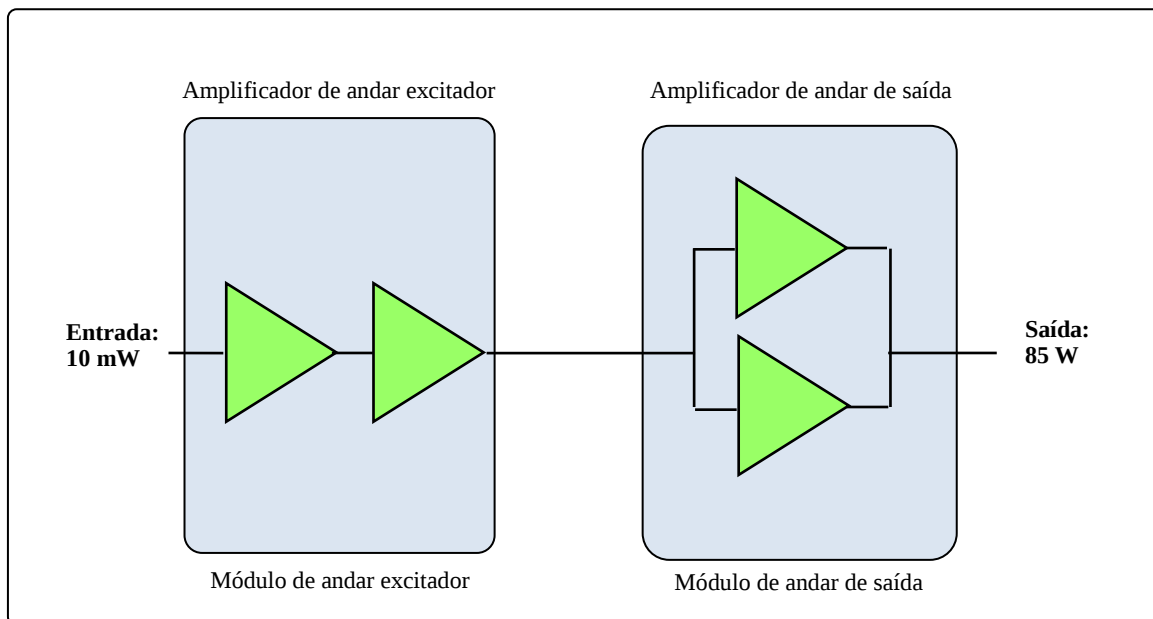
**2) *Maior flexibilidade de desenho para equipamentos rádio compatíveis com TDMA***

A configuração independente da tensão de porta para cada secção do amplificador facilita a flexibilização do desenho de equipamentos rádio compatíveis com Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo (Time Division Multiplexing Access - TDMA), uma tecnologia de acesso múltiplo em comunicações sem fios que permite a vários utilizadores partilhar o mesmo intervalo de tempo na mesma frequência

**3) *Compatíveis com várias normas internacionais de rádio digital***

O desenho de baixa latência multiplica a resposta da saída de potência à aplicação de tensão de porta por 10 (em comparação com produtos existentes), permitindo a compatibilidade com normas de rádio digital em vários países, tais como Digital Mobile Radio (DMR), digital Private Mobile Radio (dPMR), Professional Digital Trunking (PDT), Terrestrial Trunked Radio (TETRA) e APCO-P25 (P25)

### **Circuitos de transmissores dos novos módulos**



### **Consciência ecológica**

Estes produtos estão em conformidade com a diretiva 2011/65/UE sobre Restrição de utilização de certas substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrônico (RoHS).

###

### **Sobre a Mitsubishi Electric Corporation**

Com mais de 90 anos de experiência no desenvolvimento de produtos fiáveis e de alta qualidade, a Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) é um líder mundial reconhecido ao nível do fabrico, marketing e vendas de equipamento elétrico e eletrónico utilizado em comunicações e processamento de informação, descoberta do espaço e comunicações por satélite, eletrónica de consumidor, tecnologia industrial, energia, equipamento de construção e de transporte. Integrando o espírito do seu lema empresarial, Changes for the Better, e do seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser uma empresa ecológica líder a nível mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou vendas de grupo consolidadas no valor de 4394,3 mil milhões de ienes (38,8 mil milhões de dólares\*), no ano fiscal terminado a 31 de março de 2016. Para obter mais informações, visite:

[www.MitsubishiElectric.com](http://www.MitsubishiElectric.com)

\* A uma taxa de câmbio de 113 ienes para o dólar americano, determinada pelo mercado de câmbio de Tóquio a 31 de março de 2016